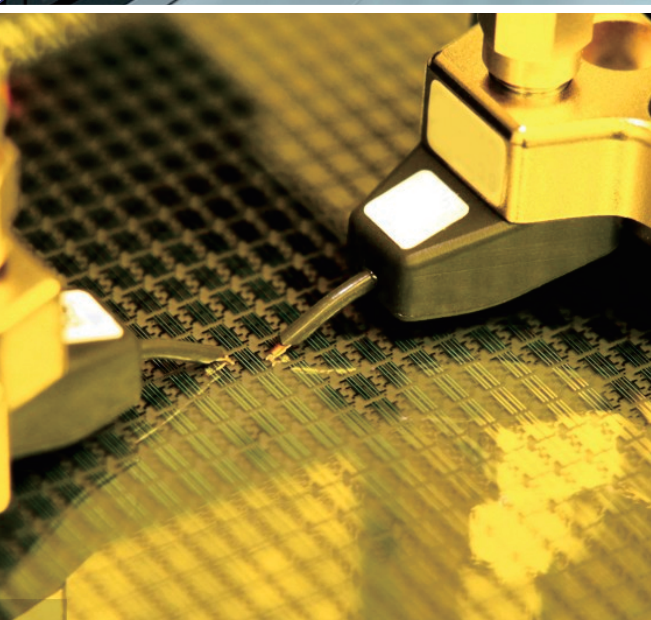




bestirpower



2025.1

**Выигрышное решение
для энергетических инноваций**



www.bestirpower.com

Введение о компании

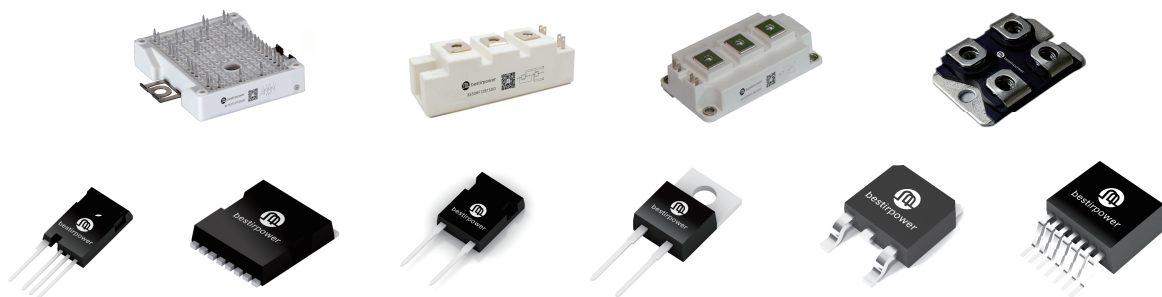


Bestir Power Ltd. — это полупроводниковая компания с частичным производственным процессом (fab-lite), расположенная в Китае. Мы специализируемся на решениях в области полупроводников для силовой электроники нового поколения. Деятельность нашей компании включает в себя: проектирование чипов, научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки устройств, производство, продажа и сервисное обслуживание.

Компания Bestir Power Ltd. нацелена на предоставление высоконадежных продуктов с оптимальным соотношением цены и производительности на рынке силовых полупроводников. Нашими клиентами являются представители промышленного и автомобильного сектора экономики, в том числе в области электромобилей, вычислительной техники, систем хранения энергии и зарядных устройств. Наш ассортимент продукции включает в себя платформы напряжением от 600В до 2000В из Si (кремния) и SiC (карбида кремния). Мы предлагаем SiC-диоды, МОП-транзисторы (MOSFETs), SJ МОП-транзисторы (SJ MOSFETs), дискретные устройства, IGBT модули, высоковольтные МОП-транзисторы и многое другое.

Компания Bestir Power обеспечивает эффективность, надежность, легкость проектирования, оптимизацию затрат на систему и отличный сервис для клиентов. У нас есть четыре офиса в Китае, расположенные в следующих городах: Шанхай, Шэньчжэнь, Нинбо и Сиань. В настоящее время в Нинбо строится фабрика площадью 40 000 м².

Основные продукты



SiC MOSFET

650V/1200V/1700V SiC MOSFET

Product	Package	VDS max	RDS(on) typ	VGS(th) typ	ID @25℃ max	QG	Ciss	Crss
BCW65N45M1	TO247-3	650V	45mΩ	2.8V	42A	55nC	1048pF	9.1pF
BCZ65N45M1	TO247-4	650V	45mΩ	2.8V	42A	55nC	1048pF	9.1pF
BCBF65N45M1	D ² PAK-7	650V	45mΩ	2.8V	42A	55nC	1048pF	9.1pF
BCT65N45M1	TOLL	650V	45mΩ	2.8V	42A	55nC	1048pF	9.1pF
BC018SG12SWSD	SOT-227	1200V	18mΩ	3.0V	110A	204nC	5880pF	10pF
BCZ120N21M1	TO247-4	1200V	21mΩ	3.0V	100A	198nC	3741pF	26pF
BCW120N21M1	TO247-3	1200V	21mΩ	3.0V	100A	209nC	3683pF	26pF
BCZ120N32W1	TO247-4	1200V	32mΩ	2.9V	69A	121nC	2812pF	7pF
BCW120N32W1	TO247-3	1200V	32mΩ	2.9V	69A	121nC	2812pF	7pF
BCW120N40M1	TO247-3	1200V	40mΩ	3.0V	60A	109nC	1960pF	5pF
BCZ120N40M1	TO247-4	1200V	40mΩ	3.0V	60A	109nC	1960pF	5pF
BCZ120N80M1	TO247-4	1200V	80mΩ	3.0V	30A	52nC	880pF	5pF
BCW120N80M1	TO247-3	1200V	80mΩ	3.0V	30A	50nC	885pF	5pF
BCBF120N80M1	D ² PAK-7	1200V	80mΩ	3.0V	30A	50nC	880pF	5pF
BCW120N160W1	TO247-3	1200V	160mΩ	3.5V	22A	40nC	550pF	8pF
BCZ120N160W1	TO247-4	1200V	160mΩ	3.5V	22A	40nC	550pF	8pF
BCL120N160W1	DFN8*8	1200V	160mΩ	3.5V	22A	40nC	550pF	8pF
BCW170N650T1	TO247-3	1700V	650mΩ	2.8V	9A	13.2nC	183pF	2.1pF
BCBF170N650T1	D ² PAK-7	1700V	650mΩ	2.8V	8.6A	13.2nC	183pF	2.1pF

SiC DIODE

650V SiC Diode

Product	Package	VRRM	IF	IFSM	VF typ	IR typ	Qc
BCD65S04D3	DPAK	650V	4A	42A	1.35V	1uA	9.5nC
BCS65S04D3	DFN5*6	650V	4A	42A	1.35V	1uA	9.5nC
BCH65S04D3	TO220-2	650V	4A	39A	1.35V	1uA	9.5nC
BCM65S04D3	TO252NC	650V	4A	39A	1.35V	1uA	9.5nC

SiC DIODE

650V SiC Diode

Product	Package	VRRM	IF	IFSM	VF typ	IR typ	Qc
BCF65S06D3	TO220F-2	650V	6A	66A	1.4V	2uA	19nC
BCH65S06D3	TO220-2	650V	6A	66A	1.4V	2uA	17nC
BCM65S06D3	TO252NC	650V	6A	76A	1.4V	2uA	22nC
BCS65S06D3	DFN5*6	650V	6A	49A	1.4V	2uA	19nC
BCF65S08D3	TO220F-2	650V	8A	76A	1.45V	2uA	22nC
BCL65S08D3	DFN8*8	650V	8A	74A	1.45V	2uA	22nC
BCH65S08D3	TO220-2	650V	8A	76A	1.45V	2uA	22nC
BCM65S08D3	TO252NC	650V	8A	74A	1.45V	2uA	22nC
BCF65S10D3	TO220F-2	650V	10A	92A	1.45V	2uA	28nC
BCH65S10D3	TO220-2	650V	10A	96A	1.45V	2uA	28nC
BCM65S10D3	TO252NC	650V	10A	64A	1.45V	2uA	28nC
BCL65S10D3	DFN8*8	650V	10A	64A	1.45V	2uA	28nC
BCH65S16D3	TO220-2	650V	16A	120A	1.45V	10uA	41nC
BCA65S20D3	TO247-2	650V	20A	170A	1.45V	2uA	65nC
BCH65S20D3	TO220-2	650V	20A	180A	1.45V	2uA	65nC
BCN65S20D3	D ² PAK-3	650V	20A	180A	1.45V	2uA	65nC
BCA65S30D3	TO247-2	650V	30A	216A	1.45V	2uA	85nC
BCH65S30D3	TO220-2	650V	30A	216A	1.45V	2uA	85nC

1200V SiC Diode

Product 产品型号	Package 封装形式	VRRM 反向峰值电压	IF 额定整流电流	IFSM 浪涌峰值电流	VF typ 正向导通电压	IR typ 反向饱和漏电流	Qc 总存储电荷
BCD120S02D3	DPAK	1200V	2A	18A	1.36V	2uA	11.2nC
BCD120S05D3	DPAK	1200V	5A	18A	1.37V	0.5uA	27nC
BCH120S10D3	TO220-2	1200V	10A	64A	1.38V	10uA	50nC
BCA120S15D2	TO247-2	1200V	15A	106A	1.39V	10uA	92nC
BCA120S20D2	TO247-2	1200V	20A	135A	1.39V	10uA	121nC
BCB120S20D2	D ² PAK	1200V	20A	135A	1.39V	10uA	121nC

SiC DIODE

1200V SiC Diode

Product	Package	VRRM	IF	IFSM	VF typ	IR typ	Qc
BCH120S20D2	TO220-2	1200V	20A	135A	1.39V	10uA	121nC
BCM120S20D2	TO252NC	1200V	20A	135A	1.39V	10uA	121nC
BCW120D30D2	TO247-3	1200V	30A	106A	1.39V	1uA	92nC
BCA120S40D2	TO247-2	1200V	40A	225A	1.39V	10uA	241nC
BCW120S40D2	TO247-3	1200V	20A/40A	135A	1.39V	10uA	121nC

SJ MOSFET

600V-650V SJ MOSFET

Product 产品型号	Package 封装形式	VDS min 漏源电压	RDS(on) max 导通电阻	VGS(th) typ 阈值电压	ID @25℃ max 最大漏源电流	QG 总存储电荷	Ciss 输入电容	Crss 反向传输特性
BMW60N026UC1	TO247-3	600V	26mΩ	3.8V	102A	145nC	7950pF	8.5pF
BMB60N076UC1	D ² PAK	600V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF
BMF60N076UC1	TO220F	600V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF
BMW60N076UC1	TO247-3	600V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF
BML60N120UC1	DFN8*8	600V	120mΩ	4V	23A	15nC	2380pF	4pF
BML60N165UC1	DFN8*8	600V	165mΩ	4V	21A	40nC	1670pF	4.3pF
BMD60N600C1	DPAK	600V	600mΩ	3V	8A	15nC	370pF	1.3pF
BMF60N600C1	TO220F	600V	600mΩ	3V	8A	15nC	370pF	1.3pF
BMD60N650UC1	DPAK	600V	650mΩ	4V	8A	15nC	406pF	1.16pF
BMD60N650UC1Z	DPAK	600V	650mΩ	4V	8A	15nC	406pF	1.16pF
BMW65N030UC1	TO247-3	650V	30mΩ	3.8V	100A	145nC	7950pF	8.5pF
BMW65N040UC1	TO247-3	650V	40mΩ	3.8V	80A	133nC	8100pF	10pF
BMW65N040UE1	TO247-3	650V	40mΩ	3.8V	72A	133nC	4900pF	1.6pF
BMT65N065UC1	TOLL	650V	65mΩ	3.8V	55A	73nC	3990pF	5pF
BMW65N065UC1	TO247-3	650V	65mΩ	3.8V	55A	73nC	3990pF	5pF
BMT65N076UC1	TOLL	650V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF
BMW65N076UC1	TO247-3	650V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF
BMB65N076UC1	D ² PAK	650V	76mΩ	4V	52A	80nC	3440pF	7pF

SJ MOSFET

650V-800V SJ MOSFET

Product	Package	VDS min	RDS(on) max	VGS(th) typ	ID @25℃ max	QG	Ciss	Crss
BMF65N100UC1	TO220F	650V	100mΩ	4V	35A	66nC	2990pF	5.8pF
BMP65N100UC1	To220	650V	100mΩ	4V	35A	66nC	2990pF	5.8pF
BMT65N100UC1	TOLL	650V	100mΩ	4V	35A	66nC	2990pF	5.8pF
BMW65N100UC1	TO247-3	650V	100mΩ	4V	35A	66nC	2990pF	5.8pF
BMF65N120UC1	TO220F	650V	120mΩ	3.8V	28A	53nC	2380pF	4pF
BMB65N140UC1	D²PAK	650V	140mΩ	3.8V	25A	45nC	2040pF	3.8pF
BMF65N190C1	TO220F	650V	190mΩ	3.8V	20A	40nC	1690pF	3.3pF
BMF65N190UC1	TO220F	650V	190mΩ	4V	20A	40nC	1690pF	3.3pF
BMW65N190UC1	TO247-3	650V	190mΩ	4V	20A	40nC	1690pF	3.3pF
BMF65N340C1	TO220F	650V	340mΩ	3.3V	14A	20.4nC	781pF	1.47pF
BMD65N340C1	DPAK	650V	340mΩ	3.3V	14A	20.4nC	781pF	1.47pF
BMS65N340C1	DFN5*6	650V	340mΩ	3.3V	14A	20.4nC	781pF	1.5pF
BMB65N380E1	D²PAK	650V	380mΩ	3.5V	9.6A	16.5nC	624pF	3.2pF
BMD65N380C1	DPAK	650V	380mΩ	3V	10.5A	23.5nC	630pF	1.4pF
BMF65N380C1	TO220F	650V	380mΩ	3V	10.5A	23.5nC	630pF	1.4pF
BMP65N380C1	TO220	650V	380mΩ	3V	10.5A	23.5nC	630pF	1.4pF
BMP80N180C1	TO220	800V	180mΩ	3.5V	23A	56nC	2440pF	1.9pF
BMB80N180C1	D²PAK	800V	180mΩ	3.5V	23A	56nC	2656pF	1.9pF
BMW80N180C1	TO247-3	800V	150mΩ	3.5V	23A	56nC	2440pF	1.9pF
BMF80N250C1	TO220F	800V	250mΩ	3V	18A	27nC	1510pF	2pF
BMP80N250C1	TO220	800V	250mΩ	3V	18A	27nC	1510pF	2pF
BMF80N360C1	TO220F	800V	360mΩ	3.5V	17A	30nC	1280pF	1.6pF

HV Planar MOSFET

600V-650V HV Planar MOSFET

Product	Package	VDSmax	ID @25°Cmax	RDS(on)max	VGS(th)max	Trr	QG	Maximum Junction Temperature
BVD50N5H1	DPAK	500V	5A	3Ω	4V	100ns	11.4nC	150°C
BVF50N13H1	TO220F	500V	13A	0.62Ω	5V	419ns	30.9nC	150°C
BVF50N18H1	TO220F	500V	18A	0.33Ω	5V	449ns	49.8nC	150°C
BVF50N20H1	TO220F	500V	20A	0.27Ω	4V	270ns	70.1nC	150°C
BVP60N12H1	TO220	600V	12A	0.74Ω	4V	447ns	43.2nC	150°C
BVF60N12H1	TO220F	600V	12A	0.74Ω	4V	447ns	43.2nC	150°C
BVB60N12H1	D ² PAK	600V	12A	0.74Ω	4V	447ns	43.2nC	150°C
BVD60N12H1	DPAK	600V	12A	0.74Ω	4V	447ns	43.2nC	150°C
BVD65N4H1	DPAK	650V	4A	3.1Ω	4V	256ns	12.6nC	150°C
BVD65N7H1	DPAK	650V	7A	1.4Ω	4V	351ns	25.9nC	150°C
BVF65N7H1	TO220F	650V	7A	1.4Ω	4V	351ns	25.9nC	150°C
BVF65N10H1	TO220F	650V	10A	1Ω	5V	730ns	33.4nC	150°C
BVF65N12H1	TO220F	650V	12A	0.8Ω	4V	870ns	42.2nC	150°C
BVF65N18H1	TO220F	650V	18A	0.55Ω	5V	632ns	52nC	150°C
BVF65N20H1	TO220F	650V	20A	0.42Ω	4V	924ns	73nC	150°C

IGBT Module

IGBT Module

Product	Package	VCES	Ic@100°C	VGES	VCE(sat)typ@25°C	VGE(th)typ@25°C	IF	ICESMax
BS150TL07E2SDD	Easy2B	650V	150A	±20V	1.57V	5.3V	150A@25°C	1mA
BS50HF12B1SDD	34mm	1200V	50A	±30V	3.5V	5.1V	50A@100°C	250uA
BS75HF12B1SDD	34mm	1200V	75A	±30V	3.0V	5.5V	150A@25°C	5mA
BS100HF12B1SDD	34mm	1200V	100A	±30V	3.0V	5.1V	200A@25°C	1mA
BS150HF12B1SDD	62mm	1200V	150A	±30V	3.0V	5.1V	300A@25°C	5mA



bestirpower



Веб-сайт



Организация

Шанхай
Нинбо
Шэньчжэнь
Сиань